

Списки публикаций оппонентов

Лебедев Александр Александрович, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН

1. Козловский,ВВ; Васильев,АЭ; Лебедев,АА. «Роль низкотемпературного отжига в модифицировании карбида кремния пучками заряженных частиц». Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, т.4 страницы: 36-40 (2021).
2. Kalinina,E; Lebedev,A; Kozlovski,V; Zabrodski,V; Nikolaev,A; Shvarts,M; Levina,S. «Effect irradiation with 15 mev protons on properties of 4h-sic uv detectors». В книге (сборнике): 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SILICON CARBIDE AND RELATED MATERIALS, ICSCRM 2019 Mater. Sci. Forum, v.1004 MSF страницы: 1104-1108 (2020).
3. Sankin,VI; Petrov,AG; Shkrebiy,PP; Kazarova,OP; Lebedev,AA. «SiC natural and artificial superlattices for the implementation of the bloch oscillation process: A comparative analysis». В книге (сборнике): 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SILICON CARBIDE AND RELATED MATERIALS, ICSCRM 2019 Mater. Sci. Forum, v.1004 MSF страницы: 256-264 (2020).
4. Lebedev,AA; Kozlovski,VV; Fursin,L; Strel`chuk,AM; Levinshtein,ME; Ivanov,PA; Zubov,A. «Impact of proton irradiation on power 4h-sic mosfets». В книге (сборнике): 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SILICON CARBIDE AND RELATED MATERIALS, ICSCRM 2019 Mater. Sci. Forum, v.1004 MSF страницы: 1074-1080 (2020).
5. Lebedev,AA. «Development and investigation of SiC and SiC-based devices». Crystals, v.10, 12 ArtNo: #1127 (2020).
6. Shakhov,LV; Lebedev,AA; Seredova,NV; Lebedev,SP; Kozlovski,VV; Zubov,AV; Nikitina,IP. «Investigation of the influence of structural defects on the pl spectra in n-3C-SiC». В книге (сборнике): 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SILICON CARBIDE AND RELATED MATERIALS, ICSCRM 2019 Mater. Sci. Forum, v.1004 MSF страницы: 278-283 (2020).
7. Eliseyev,IA; Smirnov,AN; Lebedev,SP; Panteleev,VN; Dementev,PA; Pezoldt,J; Hartung,G; Kroger,J; Zubov,AV; Lebedev,AA. «Transformation of the buffer layer grown on 4H-SiC to single-layer graphene by ex situ hydrogen intercalation». 14th International Conference “Advanced Carbon Nanostructures” (ACNS’2019); St.Petersburg, Russia; 1–5 July 2019.
8. Давыдовская,КС; Лебедев,АА; Козловский,ВВ. «Перспективы использования карбида кремния и нитрида галлия для силовой электроники». В книге (сборнике): ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ: IPDME-2020 (840 стр.) страницы: 497-500 (2020).
9. Lebedev,AA; Kozlovski,VV; Levinshtein,ME; Ivanov,AE; Strel`chuk,AM; Zubov,AV; Fursin,L. «Impact of 0.9 MeV electron irradiation on main properties of high voltage vertical power 4H-SiC MOSFETs». Radiat. Phys. Chem., v.177 ArtNo: #109200 (2020).
10. Панютин,ЕА; Шарофидинов,ШШ; Орлова,ГА; Сныткина,СА; Лебедев,АА. «Бипланарные эпитаксиальные AlN/SiC/(n,p)SiC-структуры для приборов высокотемпературной функциональной электроники». ЖТФ, т.90, 3 страницы: 450-455 (2020).